Yb :FAP 和 Yb :C₃S₂-FAP 晶体光谱的温度特性 和选择激发*

毛艳丽¹) 赵志伟²) 邓佩珍²) 干福嘉²)

¹(河南大学物理与信息光电子学院,开封 475001) ²(中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800) (2003年1月14日收到 2003年9月1日收到修改稿)

报导了 Yb FAP 和 Yb :C₃ S₂-FAP 晶体在不同温度下的吸收光谱和荧光光谱实验结果,研究发现由于电子-声子 近共振耦合作用,Yb :FAP 和 Yb :C₃ S₂-FAP 晶体均存在有明显的振动谱,Yb :FAP 晶体的零声子线在低温下还劈裂为 相差 10 cm^{-1} 的两条线.采用激光选择激发技术研究了 Yb³⁺离子在 FAP 和 C₃ S₂-FAP 晶体中的格位特征,结果表明 Yb³⁺离子在这两种基质中都只占据 Ca(]] 》格位,但由于 CaF₂的挥发,导致了 Ca(]] 》格位的局部畸变.

关键词:Yb:FAP 晶体,Yb:C₃S₂-FAP 晶体,光谱特性,选择激发 PACC:7630K,7850,7855H

1.引 言

上世纪 90 年代以来,随着 InGaAs 半导体激光 器(输出波长为 900nm—1.1μm)的发展,很快兴起了 掺 Yb³⁺激光材料的研究热潮¹⁻⁴¹,美国利夫莫尔实 验室的研究人员预言,在未来几年内,掺 Yb³⁺激光 器的输出功率将达到 10kW^[51]. 与掺 Nd³⁺晶体相比, Yb³⁺具有宽的二极管抽运吸收带,相对大的发射截 面积,高的转换效率和长的荧光寿命等特点,由于其 能级结构简单,如激发态吸收和上转换等有害过程 均不存在.

尽管目前已生长出许多掺 Yb³⁺ 的激光材料,但 其中的佼佼者当数 Yb :YAG 晶体和 Yb :Ca₅(PO₄),F (氟磷酸钙)以及 Yb :Ca_x Sr_{5-x}(PO₄), f(氟磷酸锶钙) 晶体,其中 Yb :Ca₅(PO₄), f(FAP)和 Yb :Ca_x Sr_{5-x} (PO₄), f(C_xS_{5-x} – FAP)晶体的光谱激光性能要明显 优于 Yb :YAG 晶体,它们的基质为 Yb³⁺ 离子提供较 大的晶场分裂能,它具有吸收截面和发射截面大、阈 值低、增益大、成本低等特点,因此备受人们青睐. 目前国际上对其已展开了较多的研究,对其吸收和 发射特性,光谱性能参数已有详细的报道^[6,7];用钛 宝石激光器抽运 Yb :FAP 晶体,在室温下获得的激 光斜率效率高达 79%^[8];采用 900nm 抽运波长的 InGaAs 二极管激光器抽运 Yb :S-FAP 晶体,斜率效 率达 53%^[9].

虽然目前国际上对 Yb :FAP 晶体和 Yb :C_xS_{5-x}-FAP 晶体的光谱和激光性能已展开了较多的研究, 但关于它们的光谱特性的温度效应以及选择激发特 性尚未见详细的研究报道 本文分析讨论了 Yb :FAP 和 Yb :C₃S₂-FAP 晶体在低温下的吸收光谱和荧光光 谱 采用激光选择激发研究了 Yb³⁺在 FAP 和 C₃S₂-FAP 基质中所占据的格位特征.

2. 实 验

实验中所用 Yb :FAP 和 Yb :C₃ S₂-FAP 晶体采用 引上法生长^{10]},以 CaHPO₄,CaCO₃,Yb₂O₃和 CaF₂为 原料,Yb :C₃S₂-FAP 晶体的原料制备以 SrCO₃部分代 替 CaCO₃,Yb³⁺在 FAP 和 C₃S₂-FAP 中的掺杂浓度分 别为 0.25at%,0.15at%.样品沿平行于光轴方向 (垂直于 a 方向)切割加工成 5mm × 5mm × 2mm 大 小,两大面抛光.吸收光谱和荧光光谱均在分辨率 为 4.0cm⁻¹的傅里叶红外光谱仪(Nexus870FT-IR)上 测定;所用光源为钛宝石可调谐激光器,调谐范围 850—980nm,线宽小于 1.0nm.样品放置在杜瓦瓶

^{*} 河南大学校内基金(批准号: XK01098)和国家高技术发展计划(批准号: 2002AA311030)资助的课题。

中,使其光轴方向平行于激发光源电场矢量方向(*E* // *c*). 使用液氦循环制冷机降温,温度从8K到300K连续可调.

3. 结果与讨论

图 1(a)(b)是 Yb :FAP 晶体在不同温度下的吸 收光谱和荧光光谱(E // c). Yb :FAP 晶体有三个主 吸收峰,其中心波长分别为 904,978 和 983nm,带宽 均较窄,其中904nm吸收峰的带宽约为3nm. 主发 射峰中心波长分别为 983nm 和 1.044µm,其中 983nm 是 Yb :FAP 晶体的零声子线. 从图 1 可以看到 Yb: FAP 晶体在不同温度下的吸收光谱和荧光光谱略有 不同, 从图 1(a) 可以看到 随温度升高, 其吸收峰的 峰位略有红移,带宽略有展宽,出现了955.3nm的吸 收峰,它是较高能级热布居产生的,除较强的主吸 收峰外 还有一些小的吸收峰 即使在低温下也明显 存在 而 Yb^{3+} 离子的 $^{2}F_{5/2}$ 能级最多分裂为 3 个子能 级 在低温下应只对应三个吸收峰 这些小的吸收峰 很可能是电子-声子耦合产生的振动谱,形成强的 电子-声子耦合近共振的主要条件一是有强的电子-声子耦合系数 二是在共振范围有丰富的声子振动 峰. Yb³⁺离子的电子构型为 4f¹³,由于镧系收缩 Af 壳层的电子超过 7 个其受的屏蔽越来越小,所以与 其他镧系离子相比,Yb的4f电子所受屏蔽较少因 而与周围晶格产生较强的相互作用[11],有强的电子-声子耦合系数 另外 FAP 晶体也有较为丰富的声子

振动,对 FAP 晶体的拉曼谱的研究表明,它的外在 晶格振动频率是小于 300cm⁻¹的低频振动,氟磷酸 钙晶体中的磷酸盐四面体具有强的振动,振动频率 分别为 473 ,576 ,601 ,962cm^{-1[12]},因此在 Yb :FAP 晶 体中易产生电子-声子耦合近共振作用,产生振动 谱.在图 1(b)中,Yb :FAP 晶体的荧光光谱中不只有 四个发射峰,同样表明电子-声子耦合的存在.另 外,Yb :FAP 晶体的 1.044µm 主荧光峰,即对应的激 光波长,它是一较宽的发射带,且有多峰结构. Laura 在研究了一系列的掺 Yb³⁺的磷灰石晶体后认为这 一宽带多峰结构是 Yb-O 振动与电子能级间近共振 相互作用的结果.

根据 Lupe^[13]所提出的近共振电子-声子相互作 用理论,这种作用不仅产生与电子能级跃迁强度差 不多的振动谱,而且可使零声子线产生劈裂.将图1 (a)(b)中的零声子线分别在横坐标上展开,如图2 (a)(b)所示.在8K时的吸收光谱中,Yb:FAP 晶体 的零声子吸收线983nm 劈裂为两条线,两条线的能 量分别为10172.83cm⁻¹(983nm)和10182.47cm⁻¹ (982nm)相差约10cm⁻¹.在77K荧光光谱中同样看 到983nm线的劈裂,在300K时,983nm线的劈裂因 热展宽而无法分辨,除零声子线的劈裂外,没有观察 到其他线的劈裂.

Yb :C₃S₂-FAP 晶体在不同温度下的吸收光谱和 荧光光谱(*E*//*c*)如图 ((a)(b)所示,两个强吸收峰 分别位于 983nm 和 903nm,比 Yb :FAP 晶体的吸收带 宽增加,其中 903nm 在常温下的带宽约为 7nm,这对 半导体激光器的抽运将是有利的.随温度升高,吸 收峰带宽略有增加,但峰位基本没有移动,954.6nm 处的吸收峰是随温度升高,较高能级粒子数增加所



图 1 (a)Yb :FAP 晶体在不同温度下的吸收光谱(E // c);(b)Yb :FAP 晶体在不同温度下的荧光光谱(E // c)



图 2 (a)Yb FAP 晶体在不同温度的零声子吸收线;(b)Yb FAP 晶体在不同温度的零声子荧光线

致.Yb:C₃S₂-FAP 晶体在不同温度下的荧光光谱基 本相同,主荧光峰是983nm和1.044µm.从吸收光谱 和荧光光谱可以看出,Yb:C,S,-FAP晶体不存在零 声子线的劈裂 存在一些小的不太明显的振动谱 较 为明显的是 903nm 吸收线短波边的振动峰,另外 1.044µm 的发射峰没有多峰结构.我们认为一个原 因是由于 Yb :C, S,-FAP 晶体中 Yb3+ 离子的掺杂浓 度非常低 吸收光谱和荧光光谱的强度非常小 一些 小的峰位不易观察到,另一个原因可能与基质材料 的共价性有关,以前的研究发现,在镧系离子掺杂的 晶体中 较强的电子-声子耦合出现在具有较高共价 性的基质中^[14],在Yb:C₃S₂-FAP和Yb:FAP中,锶与 钙相比,锶的半径较大,电负性略小,导致C,S,-FAP 的共价性较低,所以在 Yb :CaS,-FAP 中的电子-声子 耦合作用与 Yb :FAP 相比就较弱,由此产生的特征 谱较少.



为研究 Yb³⁺离子在 FAP 和 C₃S₂-FAP 晶体中所 占据的格位特征,我们采用激光窄线选择激发技术, 以 Yb :FAP 和 Yb :C₃S₂-FAP 晶体不同的吸收线作为 激发波长,观察它们的荧光谱线的变化.对于 Yb : FAP 晶体,分别以 983nm 和 978nm 作选择激发,获得 的荧光光谱基本上是相同的,又以每个小的振动峰 为激发波长,获得的荧光光谱也是相同的.当以 Yb :FAP 晶体 904nm 主吸收峰内的吸收波长作选择 激发时,观察到荧光峰位的移动.图4所示是在77K 时分别以 904nm 和 906nm 激发时的荧光光谱,没有 明显的其他峰位的出现,但各个主荧光峰随波长改 变而略有改变.在 Yb :C₃S₂-FAP 晶体中出现了类似 的情况,以主吸收峰 983nm 和 903nm 作为激发波长,



图 3 (a)Yb C₃S₂-FAP 晶体在不同温度下的吸收光谱(E//c);(b)Yb C₃S₂-FAP 晶体在不同温度下的荧光光谱(E//c)

获得的荧光光谱相同,对比 903nm 和 893nm 激发的 Nd³⁺ J



荧光光谱也基本相同. 但在 903nm 主吸收峰内选择

图 4 Yb :FAP 晶体在 77K 时的选择激发荧光光谱

激发波长时,荧光峰随激发波长改变.如图 5 所示 是 Yb :C₃S₂-FAP 晶体在不同激发波长下低温 77K 时 的荧光光谱 激发波长分别是 901,903 和 906nm.



图 5 Yb : C₃S₂-FAP 晶体 77K 时的选择激发荧光光谱

FAP 晶体和 C_3S_2 -FAP 晶体都属磷灰石结构,属 六方晶系,一个单胞包含两个 Ca_5 (PO₄),F 分子,10 个 Ca^{2+} 离子占据两种不同的格位,其中四个占据九 个氧配位的具有 C_3 对称性的 Ca(I)格位,另外六 个钙离子被六个氧和一个氟包围,具有 C_{1h} 对称性, 称为 Ca(II)格位. Ca(II)结点与 F⁻离子邻近,F⁻ 离子位于 Ca^{2+} 的等边三角形中心,此等边三角形平 面垂直于 c 轴,F⁻离子沿平行于 c 轴的方向排列. C_3S_2 -FAP 晶体结构与 FAP 晶体结构相同,只是以 Sr 部分代替 Ca 的位置. 对很多掺杂在磷灰石晶体中 的稀土离子发光特性的研究表明,稀土离子如

Nd³⁺ Eu³⁺ 等在这些晶体中都优先占据 Ca(Ⅱ)格 位 我们的 Yb :FAP 和 Yb :C₃S₂-FAP 晶体选择激发 的结果也表明,Yb³⁺离子在这两种晶体中只占据 Ca (Ⅲ)格位,如果占据有 Ca(Ⅰ)格位,选择激发荧光 光谱的特征应该有很大差别,因为其格位对称性不 同,Yb³⁺离子的晶场劈裂应该有很大的差异,选择 激发荧光光谱只表现出略微的峰位移动 ,而没有明 显的其他峰位出现,证明 Yb³⁺ 离子在 FAP 和 C₃S₂-FAP中只占据 Ca(]])格位,略微的峰值移动反应了 Ca(]] 格位的局部畸变.我们认为这可能与三价稀 土离子代替二价阳离子间的电荷补偿有关,不等价 的 Yb³⁺ 替代 Ca²⁺ 的格位,靠引入 O²⁻ 代替 F⁻ 进行 电价补偿,形成如图 ((a)所示的结构模式,称为 Yb (])中心. 但在晶体生长过程中 ,CaF,在高温下具 有很强的挥发性,Ca²⁺的缺失容易产生Ca²⁺空位, 形成如图 (f b)所示的结构模式,称为 Yb(Ⅱ)中心, Ca^{2+} 空位可在镜面上也可以在远处来补偿. Yb³⁺ 离



图 6 Yb³⁺ 离子在 FAP 和 C₃S₂-FAP 中所占据的 C_a(Ⅱ)格位的 两种结构模型

子在两种结构模式中仍具有 C_{1h}的对称性,只是配 位离子有变化,因此其晶场劈裂应该基本相同,只是 处于不同结构模式的 Yb³⁺离子的发光略有不同.

在 Yb :C₃ S₂-FAP 晶体中,Yb³⁺ 离子仍然是进入 Ca(]] /格位,具有 C₁,对称性,但 Yb³⁺离子可以替代 Sr ,也可以替代 Ca ,而且同样存在 CaF₂ 挥发导致的 Ca²⁺空位 形成 Yh(] /和 Yh(]])的结构模式,多格 位结构使得光谱线形展宽,表现出较明显的非均匀 展宽特征,其吸收谱线随温度升高而表现的较小的 展宽也说明了这一点.

4.结 论

Yb :FAP 晶体的低温吸收光谱和荧光光谱均存 在较明显的振动谱,这主要是由于 Yb³⁺离子有大的 电子-声子耦合系数,FAP 晶体有较为丰富的声子振动,所以易导致电子-声子耦合作用而产生振动谱. 同时这种作用还导致 Yb :FAP 晶体零声子线的劈裂,983nm 线在低温下劈裂为两条线,相差 10cm⁻¹. 相对来说,Yb :C₃S₂-FAP 晶体的振动谱特征不太明显,零声子线未产生劈裂,这一个可能的原因是由于 与 FAP 相比,C₃S₂-FAP 共价性略低,电子-声子耦合

 [1] Hiromichi Takebe , Takahiro Murata , Kenji Morinaga 1996 J. Am. Ceram. Soc. 79 681

- [2] Chen X B Song Z F and Sawanobori N 2001 Chin. Phys. 10 564
- [3] Feng Y et al 1997 Acta Phys. Sin. 46 2454 [冯衍等 1997 物理
- 学报 46 2454] [4] Liu Z P et al 2002 Acta Phys. Sin. 51 2629[柳祝平 等 2002 物 理学报 51 2629]
- [5] Payne S A and Krupke W F 1996 Optice & Photoniss News 7(8)31
- [6] Laura D D et al 1993 IEEE J. Quantum Electron. 29 1179
- [7] Yang P Z et al 1999 Acta Phot. Sin. 28 634[杨培志等 1999 光

作用相对较小. Yb :FAP 和 Yb :C₃ S₂-FAP 晶体的选 择激发荧光光谱表明 Yb³⁺ 离子在这两种基质中都 只占据 Ca(II)格位,但随激发波长的改变而表现出 的略微的峰位移动可能是由于高温下 CaF₂ 的挥发 而产生了 Ca²⁺ 空位,从而在 Yb³⁺离子周围形成了两 种类型的配位模式所致.

子学报 28 634]

- [8] Paysne S A et al 1994 IEEE J. Quantum Electron. 30 170
- [9] Gloster L A W et al 1998 Opt. Commun. 146 177
- [10] Yang P Z et al 1999 Journal of the Chinese Ceramic Society 27 219
 (in Chinese)[杨培志等 1999 硅酸盐学报 27 219]
- [11] Ellens A et al 1996 J. Lumin. 66&67 240
- [12] Laura D D et al 1994 J. Lumin. 62 85
- [13] Lupei A et al 1999 Spectrochimica Acta Part A 55 773
- [14] Vink A P and Meijerink A 2000 J. Lumin. 87-89 601

Temperature and selective excitation properties of the spectra for Yb :FAP and Yb :C₃S₂-FAP crystals *

Mao Yan-Li¹) Zhao Zhi-Wei²) Deng Pei-Zhen²) Gan Fu-Xi²)

¹⁾ (Department of Physics , Henan University , Kaifeng 475001 , China)

² (Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China)

(Received 14 January 2003; revised manuscript received 1 September 2003)

Abstract

Experimental results of the absorption and fluorescence spectra of Yb :FAP and Yb : $C_3 S_2$ -FAP crystals at different temperatures have been reported in the paper. Due to the near resonance effects of electron-phonon coupling, there are obvious vibronic peaks in the spectra of Yb :FAP and Yb : $C_3 S_2$ -FAP crystals, and the zero-phonon line is split into two lines separated by 10 cm^{-1} . The site variation of Yb³⁺ in Yb :FAP and Yb : $C_3 S_2$ -FAP has been studied by means of laser selective excitation technique. The results show that Yb³⁺ ions only occupied Ca(II) sites in the FAP and C₃ S₂-FAP crystals, and there are local distortions of Ca(II) sites, resulting from the volatilization of CaF₂.

Keywords : Yb :FAP crystal , Yb : C_3S_2 -FAP crystal , spectroscopic properties , selective excitation **PACC** : 7630K , 7850 , 7855H

^{*} Project supported by the Foundation of Henan University, Henan Province, China (Grant No. XK01098) and the National High Technology Development Program of China (Grant No. 2002AA311030).